PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

03-273087

(43)Date of publication of application: 04.12.1991

(51)Int.CI.

C09K 11/06 C08G 61/02 C08G 61/12 C08G 73/00 H05B 33/14

(21)Application number: 02-075225

(71)Applicant: SUMITOMO CHEM CO LTD

(22)Date of filing:

22.03.1990

(72)Inventor: NAKANO TSUYOSHI

DOI HIDEJI

NOGUCHI MASANOBU ONISHI TOSHIHIRO

(54) ORGANIC ELECTROLUMINESCENT ELEMENT

(57)Abstract:

PURPOSE: To obtain a thin organic electroluminescent element readily by spin coating or casting, by employing as a charge transfer material a specific conductive polymer in which aromatic rings and bonding groups are alternately combined.

CONSTITUTION: In an organic electroluminescent element in which a luminescent layer and a charge transfer layer are provided between a pair of electrodes, at least one of which being transparent or translucent, a conductive polymer having a repeating unit represented by Ar-B (Ar. an aromatic hydrocarbon group with 6 or more carbon atoms or a heterocyclic aromatic hydrocarbon group with 4 or more carbon atoms; B: CH=CH or NH) is employed for the charge transfer layer. Examples of such conductive polymer include poly-p- phenylenevinylene, poly-2,5-dialkoxy-p- phenylenevinylene, poly-2,5-dialkoxy-p- phenylenevinylene, poly-2,5-dialkoxy-p- phenylenevinylene, poly-2,5-thienylenevinylene and polyaniline.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

①特許出願公開

⑩日本国特許庁(JP)

平3-273087 ⑫公開特許公報(A)

@Int.Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

平成3年(1991)12月4日 **@公開**

11/06 C 09 K 08 G 61/02 61/12

NLF NL J NTB 7043-4H 8215--4 J -4 J 8215-8830--3K **8**815

73/00 H 05 B 33/14

未請求 請求項の数 2 (全6頁) 審査請求

会発明の名称

有機エレクトロルミネツセンス案子

Z

顧 平2-75225 204年

頭 平2(1990)3月22日 魯出

79発 翢 者 者 @発 明

強 野 中 秀 土 居

茨城県つくば市北原 6 住友化学工業株式会社内 茨城県つくば市北原 6

住友化学工業株式会社内

野 @発 明 者

企 信

住友化学工業株式会社内 茨城県つくば市北原 6 茨城県つくば市北原 6

住友化学工業株式会社内

俥 鉵 個発 明 者 大 西 住友化学工業株式会社 顧 人 る出

大阪府大阪市中央区北浜 4丁目 5番33号

光潔 弁理士 諸石 **3799** 理 人

外1名

細

1. 発明の名称

有機エレクトロルミネッセンス案子

- 2. 特許請求の範囲
- (1) 少なくとも一方が透明または半透明である一 対の電探閲に発光層および電荷輸送層を有する有 機エレクトロルミネッセンス素子において、電荷 輪送層として一般式(I)

(I) - Ar - B -

Ar: 炭素数 6 以上の芳香族炭化水素基、また は炭素数4以上のヘテロ維芳香族炭化水 柔恙、

B:-CH=CH-基あるいはーNH-基

で示される繰り返し単位を有する導電性高分子を 用いることを特徴とする有機エレクトロルミネッ センス素子

(2) 導電性高分子がポリーローフェニレンピニシ ン、ポリー2.5- ジアルキル-p-フェニレンビ ニレン、ポリー2,5-ジアルコキシーローフェニレ ンピニレン、ポリー2.5-チエニレンピニレンま

たはポリアニリンである請求項1記載の有機エレ クトロルミネッセンス素子

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、有機エレクトロルミネッセンス素子 に関するものであり、詳しくは、作製方法が簡便 で安価な各種表示装置の発光体として用いられる 有機エレクトロルミネッセンス素子と、その作製 方法に関するものである。

[従来の技術]

有機蛍光材料を用いたエレクトロルミネッセン ス素子(以下EL素子という)は、無機EL素子 に比べ、駆動電圧が低くて輝度が高く、どのよう な色の発光も容易に得ることができるという特徴 があり、多くの試みが報告されていた。しかしな がら、電極から有機物発光層へキャリアを注入し にくいために、低輝度であった。これを解決する ためにTangらは、有機物発光層に感光体として 用いられていた有機物正孔輸送材料を積層した2 層構造を作製し、高効率。高輝度のEL業子を実

現させた(特関昭59-194393号公報)。さらに、それ以後、有機物電子輸送材料と有機物正孔輸送材料で有機物発光層を挟み込んだ3層構造の素子〔ジャパン・ジャーナル・オブ・アプライド・フィジックス(Jpn. J. Appl. Phys.)27, L269(1988)〕や、発光層に種々の色素をドーピングすることにより種々の色のEL発光素子が作製されている〔ジャーナル・オブ・アプライド・フィジックス(J. Appl. Phys.)第65巻、3610頁(1989年)〕。 〔発明が解決しようとする課題〕

これまで報告されてきた有機物EL業子は発光 層や電荷輸送層を真空中で蒸着することにより、 作製されていた。しかしながら、真空蒸着法では 大量生産に向かず、また大面積の業子を作製する には限度がある。また、EL業子をLCDなどの 非発光性のバックライト照明として用いる場合、 大面積化の要求は大きく大量生産も必要である。

それに関して、ポリビニルカルパソールを代表 とした高分子半導体にペリレンやトリフェニルブ タジェンなどの蛍光物質を分散させたものをスピ ンコーティングしてEL素子の発光層にする試みがある (Polymer., 24, 748(1983)) が、膜の強度や均一な発光面を得るのに問題がある。

[課題を解決するための手段]

本発明者らは、導電性高分子の応用について係 意検討した結果、共役額が十分に長いものは、キャリアの移動度が高く、スピンコーティング法や キャスティング法等によって関便に薄膜化が可能 な電荷輸送材料として用いることができることを 見い出し、本発明に到達した。

すなわち、本発明は、少なくとも一方が透明または半透明である一対の電極間に発光層および電荷輸送層を有する有機エレクトロルミネッセンス 素子において、電荷輸送層として一般式(I)

 $-Ar - B - \qquad (I)$

Ar: 炭素数 6 以上の芳香族炭化水素基、また は炭素数 4 以上のヘテロ環芳香族炭化水 素茶、

B:-CH=CH-基あるいは「NH-基 で示される繰り返し単位を有する導電性高分子を

用いることを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス素子を提供することにある。

以下に本発明によるEL業子について詳細に説明する。

本発明に用いる一般式 (I)に示す導電性高分子は、芳香環と結合基が交互に結合した高分子である。但し、電荷輸送材として用いる場合には、 比較的共役鎮長の長いものが好ましい。

導電性高分子の合成法としては特に限定されないが、例えば次に述べるようないくつかの方法を 用いることができる。

特開平 1 -254734号公報に記載されているスルホニウム塩分解法では一般式(Ⅱ)

(Arは炭素数 6 以上の芳香族炭化水素基、または炭素数 4 以上のヘテロ環芳香族炭化水素基、R*,R*は炭素数 1 ~ 8 の炭化水素基、X- は対イオンを表す。)

で示されるモノマーを水溶液中、0℃付近でアルカリと反応させることにより得られる、倒鏡にスルホニウム塩を育する高分子中間体、あるいはそれをアルコール溶媒と反応させて得られる、アルコキシ基を倒鏡に育する高分子中間体を熱処理することにより一般式(I)に示される導電性高分子を得ることができる。

特開昭59-199746号公報に記載の脱ハロゲン化法では一般式(II)

$$X_1-CH_2-Ar-CH_2-X_1$$
 (E)

(Ar は上記と同様なものを表し、X」はハロゲンを表す。) で示されるジハロゲン化合物を溶液中で t ープトキシカリウム等のアルカリにより縮合することにより、導電性高分子を得ることができる。

また、本発明に用いる一般式(I)の導電性高分子の内でBがピニレン基の場合は、炭素数 6 以上の芳香族炭化水素、または炭素数 4 以上のヘテロ環芳香族炭化水素であり、具体的にはArが無置換のものはp-フェニレン、2,5-ジアルキルー

p-フェニレン、2.5-ジアルコキシ-p-フェ ニレン、2,5-チエニレン、2,6-ナフタレンジイ ル、5,10-アントラセンジイルが例示され、好ま しくはローフェニレンである。また、核量換芳香 族炭化水素基としては炭素数1~22の炭化水素基 または炭素数1~22のアルコキシ基を1ないし2 個核層様したものが好資に用いられる。置換基で おる炭素数1~22の炭化水素基置换基としてはメ チル、エチル、プロピル、ブチル、ペンチル、ヘ キシル、ヘプチル、オクチル、ラウリル、オクタ デシル基などが例示される。また、炭素数1~22 のアルコキシ甚としてはメトキシ、エトキシ、プ ロピルオキシ、ペンチルオキシ、ヘキシルオキシ、 ヘプチルオキシ、オクチルオキシ、ラウリルオキ シ、オクタデシルオキシ芸等が例示される。 校置 . 換芳香炭基について、より具体的にはモノメチル ーp-フェニレン、モノメトキシーp-フェニレ ン、2,5-ジメチル-p-フェニレン、2,5-ジメ トキシーローフェニレン、モノエチルーローフェ ニレン、2,5-ジエトキシーpーフェニレン、2,5

ージエチルーpーフェニレン、モノブチルーpーフェニレン、モノブトキシーpーフェニレン、2,5ージブトキシーpーフェニレン、2,5ージブトキシーpーフェニレン、2,5ージへプチルーpーフェニレン、2,5ージオクチルーpーフェニレン、2,5ージラウリルーpーフェニレン、2,5ージラウリルオキシーpーフェニレン、2,5ージステアリルーpーフェニレン、4,5ージステアリルーpーフェニレン等が例示される。

また、炭素数 4 以上のヘテロ環芳香族炭化水素 惹としては複素 5 員環が好ましく、2,5ーチエニレン、2,5ーフランジイル、2,5ーピロールジイル あるいはそれらの3位かつ/あるいは4位への置換体が例示される。より好ましくは、2,5ーチエニレン、3 ー C 1-11アルキルー2,5ーチエニレンである。

最も好ましくはArがpーフェニレン、2,5-ジ C₁₋₂ アルキルーpーフェニレン、2,5-ジC₁₋₂

アルコキシ-p-フェニレン、2,5-チエニレン である。

本発明に使用の導電性高分子のうちで、Bが ~NH~の場合は、アニリン又はアニリン誘導体を 公知の方法で電解酸化重合、あるいは化学酸化重 合することにより得られるポリアニリンおよび の誘導体が好ましい。ポリアニリンおよびその 等体を溶媒に溶解させるには、重合後、アルカリ 溶液で処理することが好ましい。アルカリとして は水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、アンモニ ア水、ヒドラジンなどが用いることができる。

上記の高分子中間体または零電性高分子を薄膜化する方法としてはスピンコート法、キャスト法などの方法で均一な薄膜を得るには、その分子量は十分高いことが必要である。重合度は5以上であり、より好ましくは、重合度10~50000である。具体的にはゲルパーミエションクロマトグラフィーによる分子量でにおいて分子量2800の標準ポリスチレンに相当する溶媒溶出位置以前に溶出する高分子量を有するものが効果的である。

スルホニウム塩分解法で得られる高分子中間体を用いる場合には共役系高分子に転換する、光の間を見ている場合には共役系高分子に転換を担定を行う。脱離処理としるが、大加、処理を行うの機の理解を表して、無処理温度によって、無処理温度を表して、無処理温度を表して、無処理温度を表して、無処理温度を表して、無処理温度を行う。具体的には200℃~400℃で無処理を行うのが好ましい。

熱処理時間については、倒額の脱離反応が起こる時間であれば特に制限はなく、一般的には10分~20時間。好ましくは30分~8時間程度である。 熱処理する際の雰囲気については、高分子フィルムの変質が起こらない雰囲気。特に酸素、空気による酸化反応が起こらない雰囲気であれば特に限定されず、一般的にはNa、Ar、He等の不活性がス雰囲気であり、また真空下あるいは不活性媒体であってもよい。

(4)

である。

高分子中間体スルホニウム塩の対イオンX⁻については、C1⁻、Br⁻等のハウゲンスを置換イオンとによって、BF_{*}-、のハウゲンイオンを置換イオンとの種類によって、BF_{*}-、シャートルエンスルホンの種類によってが類によってもあった。 対している方が無限反応が起きやすい。 対してある方が無限反応が起きやすい。 対してある方が無限である。 カートルエンスルホンの有機溶媒可能は M, N-ジメチルエンスル 帯 の 有機溶媒 可能であることが可能である。

本発明のEL案子の構造を第1図に示す。EL 案子の製造過程で用いる透明な薄膜電極としては 導電性の会属酸化物膜、半透明の金属薄膜等が用 いられる。この電極の材料として具体的には、イ ンジウム・スズ・オキサイド(ITO)酸化スズ (NESA)、Au、Pt、Ag、Cu等が用いられ、膜厚と しては50人~1 μm 程度、好ましくは100人~500 人程度であり、作製方法としては、真空蒸着法、

ぞれ化合物単独で用いるが、さらに公知の電荷輸送材料や発光材料と組み合わせて使用してもよい。すなわち、本発明における導電性高分子の電荷輸送体(例えば、トリフェニルジアミン誘導体、ペリレン誘導体など)と組み合わすことができ、また、本発明における導電性高分子の電荷輸送層は、公知の発光体(トリス(8ーヒドロキシキノリン)アルミニウム縮合多環化合物及びその誘導体等)と組み合わせることもできる。

また、電荷輸送層と発光層は(発光層/電荷輸送層)または(電荷輸送層/発光層)という2層の組み合わせの他に、(電荷輸送層/発光層/電荷輸送層)という3層の組み合わせの構造をとることもできる。3層の場合の2つの電荷輸送層は異なった材料であってもよい。

すなわち、本発明の有機EL素子の構造の一例 (電荷輸送層/発光層/電荷輸送層)を具体的に 示すと第1図のように、透明語板1上に透明電板 2を投け、さらにその上に電荷輸送層3、発光層 導電性高分子の電荷輸送圏を作製する際、一般 式 (I) で示される導電性高分子あるいはその高 分子中間体の溶液を電極上にスピンコーティング 法、キャスティング法、ディッピング法、パーコ

スパッタリング法、メッキ法などが用いられる。

法、キャスティング法、ディッピング法、パーコート法 、ロールコート法等を用いて薄膜化する。 膜厚としては、50Å~10μm、電流密度を上げて 発光効率を上げるために好ましくは100Å~1μm

なお、高分子中間体を薄膜化した場合は、その 後に熱処理を行って導電性高分子に変換させる。

また、導電性高分子に従来の電子写真で電荷輸送材料として使用されている材料を混合して用いてもよい。これらの電荷輸送材料としてトリフェニルアミン系等が例示される。

本発明において使用の発光層としては特に限定されず、例えば特開昭57-51781、同59-194393 号公報に記載されているもの等、公知のものが使 用可能である。

本発明において、発光層、電荷輸送層は、それ

4、電荷輸送層3および電極5を設けた構造を有 している。

本発明のEL集子の製造過程で用いる電子注入 陰極材料としては、AI、In、Mg、Mg-Ag合金、In -Ag合金、グラファイト薄膜等のイオン化エネル ギーの小さい金属が用いられる。膜厚としては、 50A~1 μmの案子をできる限り薄くするために 好ましくは500A~1000Aで、作製方法としては 真空蒸着法。スパッタリング法等が用いられる。

〔発明の効果〕

本発明のEL案子における電荷輸送層の材料はは熱的に安定であり、導電性高分子あるいはその中間体が有機溶媒に可溶であり賦形性に富み、素子作製が容易に行える。

・本発明によるEL素子によれば、バックライト としての面状光額。フラットパネルディスプレイ 等の装置としての好道に使用される。

(実施例)

下記に本発明の実施例を示し、さらに群しく脱明する。ただし、本発明は以下の実施例によって

何ら制限されるものではない。

実施例 1

モレキュラー・クリスタルス・アンド・リキッ ド・クリスタルス (Wol. Cryst. Lig. Cryst.) パー トE,119,173~180頁(1985)に記載の方法に従い、 過硫酸アンモニウムを酸化剤としてアニリンを化 学融化重合してポリアニリン(以下PAn)を得 た。その後、水酸化ナトリウム水溶液処理、洗浄、 乾燥し、N, N-ジメチルホルムアミド(DMF) に溶解させた。ITO薄膜をスパッタリングによ って200人の厚みで付けたガラス基板にPAnの DMF 溶液を回転数2000rpmのスピンコーティン グ法により200人の厚みで塗布した。その後、200 ℃で2時間乾燥した。次いでその上にペリレンを 蒸着法によって作成した。蒸着のときの真空度は 5×10⁻⁴Torrでペリレンの膜厚は1800Aであった。 さらにその上にアルミニウム電極を蒸着してEL 素子を完成させた。この素子に電圧45Vを印加し たところ、電流密度42mA/cm²の電流が流れ、輝度 0.11cd/a² の紫色のEL発光が観察された。輝度

は電流密度に比例していた。

実施例 2

特関平1-9221 号公報に記載の方法に従い、2,5-チェニレンジスルホニウムプロミドをアルカリで重合し、メタノールと反応させてポリー2,5-チェニレンピニレン(PTV)の中間体であるポリー2,5-チェニレンピニレン(PTV)の中間体であるポリー2,5-チェニレン・メトキシエテレンを得た。ITO薄膜をスパッタリングによって200人の厚みで付けたガラス基板に、得られたPTV中間体のDMF溶液を回転数2000rpmのスピンコーティング法により700人の厚みで塗布した。その後、N₂中で200℃、2時間熱処理した。熱処理したとここで、赤外吸収スペクトルを測定したとここで、赤外吸収スペクトルを測定したとここで、赤外吸収スペクトルを測定したところ1100cm⁻¹の中間体特有の吸収ピークがなくなっていたことから、PTV構造を確認し、電荷輸送材料とした。

次に、特開平1-79217の記載の方法に従い、2,5-ジヘプチルオキシーpーキシリレンプロミドをセーブトキシカリウムで縮重合して、ポリー2,

5-ジヘプチルオキシーpーフェニレンビニレン (HO-PPV)を得た。このクロロホルム溶液を上記JTO上に塗布したPTV薄膜上に回転数2000rpmのスピンコーティング法により1000人の厚みで塗布し、発光材料とした。さらに、その上にAI電極を蒸着によって1000人の厚みで作製した。ITO電板、AI電極には銀ペーストで囃子をとり、エポキシ樹脂で固定した。

作製した2層積層型素子に電圧35 V を印加したところ、7mA/cm*の電流密度で、輝度0.12cd/m*の黄橙色の発光が観察された。発光スペクトルのピーク放長は580mmで、HO-PPVスピンコート薄膜の蛍光のスペクトルと一致していた。また、発光強度は電流密度に比例して増加した。

実施例 3

特開昭59-199746号公報の記載に従い、pーキシリレンーピス(ジエチルスルホニウムプロミド)を水溶液中、水酸化ナトリウム水溶液を適下して重合し、ポリーpーフェニレンピニレン(以下PPV)の中間体であるポリーpーフェニレンビニ

作製した2層積層型素子に、電圧30Vを印加したところ、17mA/cm²の電流密度で、輝度0.09cd/m²の質極色の発光が確認された。発光スペクトルは実施例2と同様であった。

爽施例 4

実施例 1 と同様にして P A n を製膜して電荷輸送器とした。さらに、その上に実施例 2 と同様に

してHO-PPVをスピンコーティングし、AI電 艦を蒸着して素子を完成させた。

作製した 2 届積層型素子に、電圧 50 V を印加したところ、2mA/cm²の電流密度で、輝度 0.04cd/m²の黄橙色の発光が確認された。発光スペクトルは実施例 2 と同様であった。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明における有機エレクトロルミネッセンス素子の一実施例の概念的な断面構造を表す。

1・・・・透明差板、2・・・・透明電極、3,・・・・電荷輸送層、4・・・・発光層、5・・・・電極



